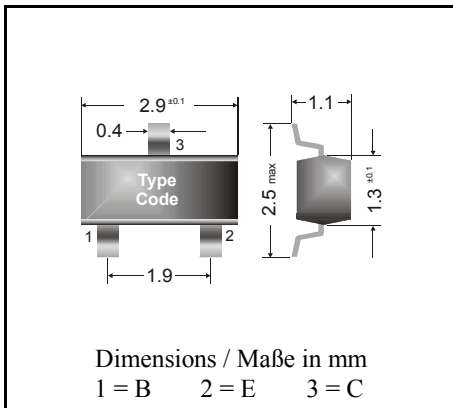


PNP

Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors
Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage

PNP



Power dissipation – Verlustleistung 250 mW

Plastic case SOT-23
Kunststoffgehäuse (TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca. 0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle**Maximum ratings (T_A = 25°C)****Grenzwerte (T_A = 25°C)**

			BSS 63
Collector-Emitter-voltage	B open	- V _{CE0}	100 V
Collector-Base-voltage	E open	- V _{CB0}	110 V
Emitter-Base-voltage	C open	- V _{EB0}	6 V
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	250 mW ¹⁾
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- I _C	100 mA
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- I _{CM}	100 mA
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		- I _{BM}	100 mA
Junction temp. – Sperrschichttemperatur		T _j	150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _S	- 65...+ 150°C

Characteristics (T_j = 25°C)**Kennwerte (T_j = 25°C)**

		Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom				
I _E = 0, - V _{CB} = 90 V	- I _{CB0}	–	–	100 nA
I _E = 0, - V _{CB} = 90 V, T _j = 150°C	- I _{CB0}	–	–	50 µA
Emitter-Base cutoff current – Emittorreststrom				
I _C = 0, - V _{EB} = 6 V	- I _{EB0}	–	–	100 nA
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungssp. ¹⁾				
- I _C = 25 mA, - I _B = 2.5 mA	- V _{CEsat}	–	–	250 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ¹⁾				
- I _C = 25 mA, - I _B = 2.5 mA	- V _{BEsat}	–	–	900 mV

¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾			
- $V_{CE} = 1\text{ V}$, - $I_C = 10\text{ mA}$ h_{FE}	30	–	–
- $V_{CE} = 1\text{ V}$, - $I_C = 25\text{ mA}$ h_{FE}	30	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz			
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 25\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$ f_T	50 MHz	85 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität			
- $V_{CB} = 10\text{ V}$, $I_E = i_e = 0$, $f = 1\text{ MHz}$ C_{CB0}	–	3 pF	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R_{thA}		420 K/W ²⁾
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren	BSS 64		
Marking - Stempelung	BSS 63 = BM		

¹⁾ Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

²⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß